1. **Kikuo Tominaga, Hidenori Fukumoto, Kumiko Kondo, Yukako Hayashi, Kei-ichiro Murai, Toshihiro Moriga *and* Ichiro Nakabayashi :** Al-impurity-doped Transparent Conductive Oxide Films of In2O3-ZnO System, *Vacuum,* **74,** *3-4,* 683-687, 2004.
2. **Kaoru Ohya, Yoshihiko Nakayama, Yoshitaka Hamada, Tetsuo Tanabe, Andreas Kirschner, Volker Philipps *and* Nobuaki Noda :** Modeling of Material Mixing Effects on Plasma Surface Interactions in Magnetic Fusion Devices, *Physica Scripta,* **T111,** 138-144, 2004.
3. **Kazuya Kusaka, Takao Hanabusa *and* Kikuo Tominaga :** Measurement of crystal orientation and residual stress in GaN film deposited by RF sputtering with powder target, *Vacuum,* **74,** *3-4,* 613-618, 2004.
4. **Tao Wang, J P Parbrook, N C Harrison, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Highly improved performance of a 350nm ultraviolet light-emitting diode containing AlxGa1-xN/AlyGa1-yN distributed Bragg reflectors, *Journal of Crystal Growth,* **267,** *3-4,* 583-587, 2004.
5. **Retsuo Kawakami, Tomohisa Shimada, Yoshio Ueda *and* Masahiro Nishikawa :** Simulation Study of Dynamical Material Mixing on Tungsten Surfaces at Elevated Temperatures due to Hydrogen and Carbon Mixed Ion Beam Irradiation, *Journal of Nuclear Materials,* **329-333,** *0,* 737-741, 2004.
6. **Takenori Mitani, Retsuo Kawakami *and* Shuhei Kuriu :** Simulation Study of Sputtering Erosion and Impurity Deposition on Carbon and Tungsten Surfaces Irradiated with Deuterium Plasmas Including Carbon Impurity, *Journal of Nuclear Materials,* **329,** *329-333,* 830-835, 2004.
7. **Yoshio Ueda, Takahisa Funabiki, Tomohisa Shimada, Retsuo Kawakami *and* Masahiro Nishikawa :** Effects of Carbon Impurity in Fusion Plasmas on Erosion of RAF First Wall, *Journal of Nuclear Materials,* **329-333,** 771-774, 2004.
8. **Tomohisa Shimada, Takahisa Funabiki, Retsuo Kawakami, Yoshio Ueda *and* Masahiro Nishikawa :** Carbon Behavior on Tungsten Surface after Carbon and Hydrogen Mixed Beam Irradiation, *Journal of Nuclear Materials,* **329-333,** *0,* 747-751, 2004.
9. **Kazuhito Tajima, Shigeru Nakamura, Furukawa A. *and* Sasaki T. :** Hybrid-integrated Symmetric Mach-Zehnder all-optical switches and ultrafast signal processing, *IEICE Transactions on Electronics,* **87,** *7,* 1119-1125, 2004.
10. **Yu-Huai Liu, Hong-Dong Li, Jin-Ping Ao, Young-Bae Lee, Tao Wang *and* Shiro Sakai :** Influence of undoped GaN layer thickness to the performance of AlGaN/GaN-based ultraviolet light-emitting diodes, *Journal of Crystal Growth,* **268,** *1-2,* 30-34, 2004.
11. **Kazuya Kusaka, Takao Hanabusa, Kikuo Tominaga *and* Noriyoshi Yamauchi :** Effect of Substrate Temperature on Crystal Orientation and Residual Stress in Radio Frequency Sputtered Gallium-Nitride Films, *Journal of Vacuum Science & Technology A,* **22,** *4,* 1587-1590, 2004.
12. **Toshihiro Moriga, Yukako Hayashi, Kumiko Kondo, Yusuke Nishimura, Kei-ichiro Murai, Ichiro Nakabayashi, Hidenori Fukumoto *and* Kikuo Tominaga :** Transparent Conducting Amorphous Zn-Sn-O Films Deposited by Simultaneous DC Sputtering, *Journal of Vacuum Science & Technology A,* **22,** *4,* 1705-1710, 2004.
13. **Kaoru Ohya *and* Tohru Ishitani :** Monte Carlo simulation of topographic contrast in scanning ion microscope, *Journal of Electron Microscopy,* **53,** *3,* 229-235, 2004.
14. **Fawang Yan, Masashi Tsukihara, Akihiro Nakamura, Takayuki Yadani, Tetsuya Fukumoto, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** Surface smoothing mechanism of AlN film by initially alternating supply of ammonia, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 2 (Letters),* **43,** *8B,* L1057-L1059, 2004.
15. **Yoshitaka Hamada, Shinji Ebisu *and* Kaoru Ohya :** Transition Behaviour between Erosion and Deposition on a Tungsten Surface Exposed to Deuterium Plasmas Containing Carbon Impurities, *Japanese Journal of Applied Physics,* **43,** *9A,* 6385-6391, 2004.
16. **Kaoru Ohya, Tetsuo Tanabe, Marek Rubel, Motoi Wada, Tadashi Ohgo, Takeshi Hirai, Volker Philipps, Andreas Kirschner, Albrecht Pospieszczyk, Alexander Huber, Genadij Sergienko, S. Brezinsek *and* Nobuaki Noda :** Modeling of erosion and deposition patterns on C-W and W-Ta twin limiters exposed to the TEXTOR edge plasmas, *Journal of Nuclear Materials,* **329-333,** *Part A,* 732-736, 2004.
17. **Kaoru Ohya *and* Tohru Ishitani :** Monte Carlo study of secondary electron emission from SiO2 induced by focused gallium ion beams, *Applied Surface Science,* **237,** *1-4,* 602-606, 2004.
18. **Kazuya Kusaka, Takao Hanabusa, Kikuo Tominaga *and* Noriyoshi Yamauchi :** Effect of substrate temperature on crystal orientation and residual stress in RF sputtered galium nitride films, *Materials Science Forum,* **490-491,** 613-618, 2005.
19. **Mitsuhiko Hataya, Takao Hanabusa, Kazuya Kusaka, Kikuo Tominaga *and* Tatsuya Matsue :** Residual stress measurement in sputtered copper thin films by synchrotron radiation and ordinary X-rays, *Materials Science Forum,* **490-491,** 661-668, 2005.
20. **Retsuo Kawakami :** Simulation Study on Influence of Chemically Eroded Carbon Impurity Transport on Net Sputtering Erosion of Carbon Materials Exposed to Edge Fusion Plasmas, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 1 (Regular Papers & Short Notes),* **44,** *2,* 1069-1075, 2005.
21. **森賀 俊広, 林 由佳子, 三河 通男, 村井 啓一郎, 富永 喜久雄 :** 第3世代透明導電性アモルファス薄膜の創製, *徳島大学工学部研究報告, 50,* 7-12, 2005年.
22. **Kazuhiro Nishizono, Masaya Okada, Minoru Kamei, Daigo Kikuta, Kikuo Tominaga, Yasuo Ohno *and* Jin-Ping Ao :** Metal/Al-doped ZnO ohmic contact for AlGaN/GaN high electron mobility transistor, *Applied Physics Letters,* **84,** *20,* 3996-3998, 2004.
23. **Naotaka Kubota, Jin-Ping Ao, Daigo Kikuta *and* Yasuo Ohno :** Schottky Barrier Height Determination by Capacitance-Voltage Measurement on n-GaN with Exponential Doping Profile, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 1 (Regular Papers & Short Notes),* **43,** *7A,* 4159-4160, 2004.
24. **Tohru Ishitani *and* Kaoru Ohya :** Comparative study of scanning ion microscope and scanning electron microscope images using Monte Carlo simulations, *Microscopy and Microanalysis,* **10,** *Suppl 02,* 140-141, 2004.
25. **川上 烈生, 山上 喜廣, 富永 喜久雄, 服部 敦美, 來山 征士, 大野 泰夫 :** デジタル化・ネットワーク化時代の電気電子工学学生実験, *徳島大学高度情報化基盤センター「広報」,* **12,** 57-60, 2005年2月.
26. **Retsuo Kawakami *and* Mitani Takenori :** Simulation Study on Influence of Chemically Eroded Higher Hydrocarbons on SOL Impurity Transport and Effect of Dynamical Material Mixing on Erosion/Deposition of Tungsten Surfaces Exposed to Plasma Boundary, *16th International Conference on Plasma Surface interactions in Controlled Fusion Devices,* P1-29, Portland Maine, U.S.A., May 2004.
27. **Kazuya Kusaka, Takao Hanabusa, Kikuo Tominaga *and* Noriyoshi Yamauchi :** Effect of Substrate Temperature on Crystal Orientation and Residual Stress in RF Sputtered Gallium Nitride Films, *Proceedings of the 7th International Conference on Residual Stresses,* 613-618, Xi'an, Jun. 2004.
28. **Mitsuhiko Hataya, Takao Hanabusa, Kazuya Kusaka, Kikuo Tominaga, Tatsuya Matsue *and* Osami Sakata :** Residual Stress Measurement in Sputtered Copper Thin Films by Synchrotron Radiation and Ordinary X-rays, *Proceedings of the 7th International Conference on Residual Stresses,* 661-666, Xi'an, Jun. 2004.
29. **Daigo Kikuta, Ryohei Takaki, Junya Matsuda, Masaya Okada, Xin Wei, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Gate Leakage Reduction Mechanism of AlGaN/GaN MIS-HFETs, *2004 International Conference on Solid State Devices and Materials,* Tokyo, Sep. 2004.
30. **Kaoru Ohya, Kensuke Inai *and* Ishitani Tohru :** Reconstruction of pseudo secondary electron images in scanning ion microscope, *15th International Workshop on Inelastic Ion Surface Collisions,* Mie, Japan, Oct. 2004.
31. **Michio Mikawa, Toshihiro Moriga, Yuji Sakakibara, Yukinori Misaki, Kei-ichiro Murai, Ichiro Nakabayashi *and* Kikuo Tominaga :** Preparation of ZnO-In2O3 transparent conducting films by pulsed laser depositon, *11th International Workshop on Oxide Electronics,* Hakone, Oct. 2004.
32. **Toshihiro Moriga, Michio Mikawa, Yuji Sakakibara, Yukinori Misaki, Kei-ichiro Murai, Ichiro Nakabayashi *and* Kikuo Tominaga :** Effects of introduction of argon on structural and transparent conducting properties of ZnO-In2O3 thin films prepared by pulsed laser deposition, *11th International Workshop on Oxide Electronics,* Hakone, Oct. 2004.
33. **Retsuo Kawakami :** Simulation Study on Effects of Chemically Eroded Methane and Ethylene Molecules on Carbon Impurity Transport and Net Erosion of Carbon Materials, *Joint Meeting of 14th Internaitional Toki Conference on Plasma Physics and Controlled Nuclear Fusion & 4th International Conference on Atomic and Molecular Data and Their Application,* 73, Toki, Oct. 2004.
34. **Yukako Hayashi, Kumiko Kondo, Yusuke Nishimura, Hiroshi Suketa, Kei-ichiro Murai, Toshihiro Moriga, Ichiro Nakabayashi *and* Kikuo Tominaga :** Characterizations of Transparent Conducting Amorphous ZnO-SnO2 Films Deposited by Opposed Target Sputtering System, *The 13th International Conference on Processing and Fabrication of Advanced Materials,* **1,** 209-218, Singapore, Dec. 2004.
35. **旗谷 充彦, 野田 和宏, 日下 一也, 富永 喜久雄, 英 崇夫, 松英 達也, 坂田 修身 :** ナノサイズCu薄膜の残留応力測定, *日本材料学会四国支部第5期総会·学術講演会講演論文集,* 5-6, 2004年4月.
36. **高木 亮平, 岡田 政也, 菊田 大悟, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFETのサイドゲート効果における光の影響, *日本物理学会中四国支部，応用物理学会中四国支部，物理教育学会四国支部連絡協議会2004年度支部学術講演会,* 2004年7月.
37. **林 由佳子, 西村 勇介, 助田 祐志, 近藤 久美子, 森賀 俊広, 村井 啓一郎, 中林 一朗, 富永 喜久雄 :** ZnO-In2O3系アモルファス透明導電膜の評価, *第65回日本応用物理学会学術講演会,* 2004年9月.
38. **岡田 政也, 高木 亮平, 菊田 大悟, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFET 電流電圧特性における光応答, *第65回応用物理学会学術講演会,* 2004年9月.
39. **川上 烈生 :** SOLプラズマ中の炭素不純物輸送への高次炭化水素CxDyの寄与, *平成16年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 39, 2004年9月.
40. **上田 良夫, 崎園 大, 沢村 功, 島田 朋尚, 川上 烈生, 西川 雅弘 :** タングステン第一壁上の炭素混合層の形成メカニズム, *プラズマ核融合学会 第20回年会 講演論文集,* 2004年11月.
41. **川上 烈生 :** プラズマ対向壁としての低放射化フェライト鋼F82Hの損耗特性, *平成17年電気学会全国大会講演論文集,* 222, 2005年3月.
42. **山上 喜廣, 川上 烈生, 富永 喜久雄, 岩崎 聡一郎, 松田 潤也 :** 電気回路の過渡現象に関する創成型学生実験への取り組みとその教育効果, *平成17年電気学会全国大会講演論文集,* 1, 2005年3月.
43. **富永 喜久雄, 林 由佳子, 森賀 俊広, 中林 一朗 :** ZnO-SnO2, ZnO-In2O3透明導電膜の作製と評価, *平成17年電気学会全国大会講演論文集,* **3,** 3-S19(1)-3-S19(2), 2005年3月.
44. **西村 勇介, 助田 祐志, 林 由佳子, 村井 啓一郎, 森賀 俊広, 中林 一朗, 富永 喜久雄 :** ZnO-SnO2系アモルファス透明導電膜へのAl，Gaドーピングの影響, *第52回応用物理学関連連合講演会,* 2005年3月.
45. **高木 亮平, 岡田 政也, 菊田 大悟, 敖 金平, 大野 泰夫 :** 熱酸化によるAlGaN/GaN MIS-HFETゲート電流の低減, *第52回応用物理学関係連合講演会,* 2005年3月.
46. **岡田 政也, 高木 亮平, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFETしきい値電圧の温度及び光照射依存性, *第52回応用物理学関係連合講演会,* 2005年3月.
47. **川上 烈生 :** デタッチプラズマ照射下の炭素材から放出された炭素不純物の振舞いに関する研究, *平成16年度核融合科学研究所LHD数値解析システム利用共同研究報告書,* 日本, 2005年3月.
48. **富永 喜久雄 :** (共著)脱ITOに向けた透明導電膜の低抵抗・低温・大面積製膜技術, 株式会社 技術情報協会, 東京, 2005年7月.
49. **酒井 士郎, 高橋 清, 他 :** ワイドギャップ半導体光・電子デバイス, 森北出版 株式会社, 東京, 2006年2月.
50. **Kaoru Ohya, Tetsuo Tanabe, Andreas Kirschner, Takeshi Hirai, Volker Philipps, Motoi Wada, Tadashi Ohgo *and* Nobuaki Noda :** Dynamic transition between erosion and deposition on a tungsten surface exposed to edge plasmas containing carbon impurities, *Journal of Nuclear Materials,* **337-339,** 882-886, 2005.
51. **Retsuo Kawakami *and* Mitani Takenori :** Simulation Study on Influence of Chemically Eroded Higher Hydrocarbons on SOL Impurity Transport and Effect of Dynamical Material Mixing on Erosion/Deposition of Tungsten Surfaces Exposed to Plasma Boundary, *Journal of Nuclear Materials,* **337-339,** 45-49, 2005.
52. **Tao Wang, G Raviprakash, F Ranalli, N C Harrison, Jie Bai, R J P David, J P Parbrook, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Effect of Strain Relaxation and Exciton Localization on Performance of 350-nm AlInGaN Quantum Light-Emitting Diodes, *Journal of Applied Physics,* **97,** *8,* 083104-1-083104-4, 2005.
53. **Daigo Kikuta, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Evaluation of Surface States of AlGaN/GaN HFET Using Open-Gated Structure, *IEICE Transactions on Electronics,* **E88-C,** *4,* 683-689, 2005.
54. **Daigo Kikuta, Ryohei Takaki, Junya Matsuda, Masaya Okada, Xin Wei, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Gate Leakage Reduction Mechanism of AlGaN/GaN MIS-HFETs, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 1 (Regular Papers & Short Notes),* **44,** *4B,* 2479-2482, 2005.
55. **Kikuo Tominaga, Hidenori Fukumoto, Kumiko Kondo, Yukako Hayashi, Kei-ichiro Murai, Toshihiro Moriga *and* Ichiro Nakabayashi :** Amorphous Transparent Conductive Oxide Films of In2O3-ZnO with Additional Al2O3 Impurities, *Journal of Vacuum Science & Technology A,* **23,** *3,* 401-407, 2005.
56. **R.J. Choi, S. Kubo, M. Tsukihara, K. Inoue, Yoshiki Naoi, Katsushi Nishino *and* Shiro Sakai :** Effects of V/III flux ratio on AlInGaN/AlGaN quantum wells grown by atmospheric pressure MOCVD, *Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics,* **2,** *7,* 2149-2152, 2005.
57. **Michio Mikawa, Toshihiro Moriga, Yuji Sakakibara, Yukinori Misaki, Kei-ichiro Murai, Ichiro Nakabayashi *and* Kikuo Tominaga :** Characterization of ZnO-In2O3 transparent conducting films by pulsed laser deposition, *Materials Research Bulletin,* **40,** *6,* 1052-1058, 2005.
58. **Fawang Yan, Yoshiki Naoi, Masashi Tsukihara, Takayuki Yadani *and* Shiro Sakai :** Interdiffusion induced In(Ga)NAs films growth on GaAs substrates by low-pressure metalorganic chemical vapor deposition, *Journal of Crystal Growth,* **282,** *1-2,* 29-35, 2005.
59. **Toshihiro Moriga, Michio Mikawa, Yuji Sakakibara, Yukinori Misaki, Kei-ichiro Murai, Ichiro Nakabayashi *and* Kikuo Tominaga :** Effects of introduction of argon on structural and transparent conducting properties of ZnO-In2O3 thin films prepared by pulsed laser deposition, *Thin Solid Films,* **486,** *1,* 53-57, 2005.
60. **Kensuke Inai *and* Kaoru Ohya :** Dynamic Monte Carlo Simulation of Compositional and Topography Changes Induced by Ion Beam Irradiation, *e-Journal of Surface Science and Nanotechnology,* **4,** 32-38, 2006.
61. **Retsuo Kawakami, Tomohisa Shimada, Yoshio Ueda *and* Masahiro Nishikawa :** Influence of Carbon Impurity on Net Erosion of Reduced-Activation Ferritic/Martensitic Steel and Tungsten Materials Exposed to Hydrogen and Carbon Mixed Ion Beam Relevant to Fusion Plasma Boundary, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 1 (Regular Papers & Short Notes),* **45,** *1A,* 221-227, 2006.
62. **Takashi Okimoto, Masashi Tsukihara, Kazuhide Sumiyoshi, Ken Kataoka, Katsushi Nishino, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** Effect of GaNP Buffer Layer on AlGaN Epilayers Deposited on (0001) Sapphire Substrates by Metalorganic Chemical Vapor Deposition, *Japanese Journal of Applied Physics, Part 2 (Letters),* **45,** *8,* L236-L238, 2006.
63. **Kaoru Ohya, Tetsuo Tanabe *and* Jun Kawata :** Simulation of redeposition patterns of hydrocarbons released from carbon target in divertors, *Fusion Engineering and Design,* **81,** *1-7,* 205-210, 2006.
64. **Shinji Ebisu, Kaoru Ohya *and* Tetsuo Tanabe :** Dynamic erosion and deposition on carbon and tungsten sue to simultaneous bombardment with deuterium and beryllium ions in plasmas, *Fusion Engineering and Design,* **81,** *1-7,* 253-258, 2006.
65. **Retsuo Kawakami :** Simulation Study on Effects of Chemically Eroded Methane and Ethylene Molecules on Carbon Impurity Transport and Net Erosion of Carbon Materials, *Journal of Plasma and Fusion Research SERIES,* **7,** 94-97, 2006.
66. **Daigo Kikuta, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Gate leakage and electrical performance of AlGaN/GaN MIS-type HFET with evaporated silicon oxide layer, *Solid-State Electronics,* **50,** *3,* 316-321, 2006.
67. **Yoshiki Naoi, Hisao Sato, Hiroshi Yamamoto, Kodai Ono, Akihiro Nakamura, Masahiro Kimura, Suguru Nouda *and* Shiro Sakai :** Growth and fabrication of AlGaInN-based UV-LEDs using SiN nano-mask, *Proceedings of SPIE,* **5722,** 417-422, San Jose, Apr. 2005.
68. **Retsuo Kawakami :** Simulation study of carbon impurity dynamics on reduced-activation ferritic/martensitic steel material at elevated temperatures under hydrogen exposure, *7th International Symposium on Fusion Nuclear Technology,* 191, Tokyo, May 2005.
69. **Fawang Yan, Yoshiki Naoi, Masashi Tsukihara, Shuichi Kawamichi, Takayuki Yadani *and* Shiro Sakai :** Diffusion Effect Induced InAsN Films Growth on GaAs(100) Substrates by MOCVD, *The 23rd International Conference on Defects in Semiconductors (ICDS-23),* TuP.79, Higashiura, Jul. 2005.
70. **Toshihiro Moriga, Yusuke Nishimura, Hiroshi Suketa, Kei-ichiro Murai, Kikuo Tominaga *and* Ichiro Nakabayashi :** Effects of Al, Ga -Doping on Transparent Conducting Properties of Amorphous ZnO -SnO2 Films, *Advanced Materials Development & Performance Conference 2005,* Auckland, Jul. 2005.
71. **Masaya Okada, Ryohei Takaki, Daigo Kikuta, Jin-Ping Ao *and* Yasuo Ohno :** Temperature and Illumination Dependence of AlGaN/GaN HFET Threshold Voltage, *2005 Topical Workshop on Heterostructure Microelectronics,* Hyogo, Aug. 2005.
72. **Daigo Kikuta, Jin-Ping Ao, Junya Matsuda *and* Yasuo Ohno :** A Mechanism of Enhancement-mode Operation of AlGaN/GaN MIS-HFET, *2005 Topical Workshop on Heterostructure Microelectronics,* Hyogo, Aug. 2005.
73. **Yoshiki Naoi, Akihiro Nakamura, Kodai Ono, Hisao Sato, H Yamamoto, M Mikura, Suguru Nouda *and* Shiro Sakai :** Impurity induced disordering of p-type AlGaN-GaN Superlat-tice Structures, *6th International Conference on Nitride Semiconductors,* Th-P-023, Bremen, Aug. 2005.
74. **Kazuhide Sumiyoshi, Masashi Tsukihara, Fawang Yan *and* Shiro Sakai :** AlGaN Films grown on trenched sapphire substrates using a low-temperature GaNP buffer layer by MOCVD, *6th international conference on nitride semiconductors,* Tu-P-089, Bremen, Germany, Aug. 2005.
75. **Jin-Ping Ao, Ryota Kan, Toshio Hirao, Hideki Okada, Masaya Okada, Daigo Kikuta, Shinobu Onoda, Hisayoshi Itoh *and* Yasuo Ohno :** Gamma Radiation Effects on the Ohmic Contact of AlGaN/GaN HEMTs, *2005 International Conference on Solid State Devices and Materials,* 478-479, Kobe, Sep. 2005.
76. **Kensuke Inai *and* Kaoru Ohya :** Dynamic Monte Carlo simulation of Compositional and Topography Changes Induced by Ion Beam irradiation, *International Symposium on Surface Science and Nanotechnology,* Saitama, Japan, Nov. 2005.
77. **Kaoru Ohya *and* Kensuke Inai :** Simulation of redeposition patterns in the gaps between divertor tiles, *12th International Conference on Fusion Reactor Materials,* California, USA, Nov. 2005.
78. **Y Sumiyoshi, Masashi Tsukihara, Ken Kataoka, Kiyoshi Okimoto, Shuichi Kawamichi, Yoshiki Naoi *and* Shiro Sakai :** High-quality AlGaN film grown on the patterned sapphire substrate using a low-temperature intermediate layer by MOCVD, *International COE Workshop on Nano Processes and Devices, and Their Applications,* 75-76, Nagoya University, Dec. 2005.
79. **榊原 友士, 高田 望美, 三河 通男, 村井 啓一郎, 森賀 俊広, 中林 一朗, 富永 喜久雄 :** PLD法によるサファイア基板上へのZnO-In2O3系透明導電膜の作製と評価, *第52回応用物理学関連連合講演会,* 2005年4月.
80. **菊田 大悟, 敖 金平, 松田 潤也, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN MIS-HFET のエンハンスメント動作, *第52回応用物理学関係連合講演会,* 2005年4月.
81. **助田 祐志, 西村 勇介, 高田 大輔, 富永 喜久雄, 村井 啓一郎, 森賀 俊広 :** ポリカーボネート基板上に作製したZnO-In2O3系 アモルファス透明導電膜, *日本物理学会中国支部·四国支部 応用物理学会中国四国支部 2005年度支部学術講演会,* 2005年7月.
82. **川上 烈生 :** 炭素不純物を含む水素イオンで照射されたタングステン材表面の付着炭素不純物の振舞い, *第66回秋季応用物理学会学術講演会論文集, 2,* 630, 2005年9月.
83. **月原 政志, 住吉 和英, 閻 発旺, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** 高品質AlGaNへ向けての低温成長AlGaN層の検討, *第66回応用物理学会学術振興会講演予稿集,* 274, 2005年9月.
84. **直井 美貴, 中村 晃啓, 小野 耕大, 酒井 士郎, 木村 真大, 納田 卓 :** p-AlGaN/GaN 超格子構造における不純物ドーピングによる混晶化, *第66回応用物理学会学術振興会講演予稿集,* 279, 2005年9月.
85. **住吉 和英, 月原 政志, 河道 修一, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** 低温GaNPバッファー層を用いた加工サファイア基板上のAlGaN MOCVD成長, *第66回応用物理学会学術振興会講演予稿集,* 269, 2005年9月.
86. **閻 発旺, 住吉 和英, 月原 政志, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** MOCVD法によるサファイア基板上へのSb添加AlNの成長, *第66回応用物理学会学術振興会講演予稿集,* 269, 2005年9月.
87. **菅 良太, 平尾 敏雄, 小野田 忍, 伊藤 久義, 岡田 英輝, 岡田 政也, 菊田 大悟, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFET電気特性へγ線照射の影響, *第66回応用物理学会学術講演会,* 2005年9月.
88. **松田 潤也, 菊田 大悟, 敖 金平, 大野 泰夫 :** 周波数可変カーブトレーサを用いたAlGaN/GaN MIS-HFETヒステリシスの解析, *第66回応用物理学会学術講演会,* 2005年9月.
89. **榊原 友士, 石田 勝也, 三河 通男, 村井 啓一郎, 森賀 俊広, 富永 喜久雄 :** PLD法によりc-サファイア基板上に作製したZnO-In2O3系透明導電膜の評価, *第66回応用物理学会学術講演会,* 2005年9月.
90. **三河 通男, 榊原 友士, 石田 勝也, 富永 喜久雄, 村井 啓一郎, 森賀 俊広 :** PLD法により作製したZnO-In2O3系透明導電膜の構造·特性に及ぼす基板の影響, *第66回応用物理学会学術講演会,* 2005年9月.
91. **高田 大輔, 富永 喜久雄, 西村 勇介, 助田 祐志, 村井 啓一郎, 森賀 俊広 :** Al2O3不純物添加 アモルファスZnO-In2O3系透明導電膜の特性, *第66回応用物理学会学術講演会,* 2005年9月.
92. **山本 真美子, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** フラックス法によるBP結晶成長, *電気関係学会四国支部連合大会,* 151, 2005年9月.
93. **河道 修一, 住吉 和英, 月原 政志, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** 加工サファイア上に成長したAl0.07Ga0.93N薄膜の透過型電子顕微鏡による評価, *電気関係学会四国支部連合大会,* 150, 2005年9月.
94. **沖本 聖, 月原 政志, 住吉 和英, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** AlGaN-MOCVD成長における GaNPバッファ層の効果, *電気関係学会四国支部連合大会,* 149, 2005年9月.
95. **松田 義和, 菅 良太, 山岡 優哉, 敖 金平, 大野 泰夫 :** AlGaN/GaN HFET構造を用いたショットキーダイオード, *平成17年度電気関係学会四国支部連合大会,* 2005年9月.
96. **川上 烈生 :** 非平衡プラズマの自己組織化とドライエッチングとの関連性, *平成17年度電気関係学会 四国支部連合大会 講演論文集,* 36, 2005年9月.
97. **住吉 和英, 酒井 士郎, 直井 美貴, 西野 克志 :** 窒化物半導体と紫外発光デバイス, *第7回IEEE広島支部学生シンポジウム(HISS),* 2005年11月.
98. **山本 真美子, 月原 政志, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** フラックス成長BP結晶上へのGaN成長, *第53回応用物理学会学術振興会講演予稿集,* **22,** 346, 2006年3月.
99. **住吉 和英, 月原 政志, 沖本 聖, 河道 修一, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎 :** 低温中間層を用いた加工サファイア基板上のAl0.17Ga0.83N MOCVD成長, *第53回応用物理学会学術振興会講演予稿集,* **25,** 378, 2006年3月.
100. **河道 修一, 西野 克志, 住吉 和英, 月原 政志, 酒井 士郎 :** 凹凸サファイア基板上に成長させたAlGaN薄膜の反転ドメイン, *第53回応用物理学会学術振興会講演予稿集,* **25,** 379, 2006年3月.
101. **池田 賢司, Choi Rak-Jun, 福本 哲也, 西野 克志, 直井 美貴, 酒井 士郎, Lee Min Soo, 小池 正好 :** AlInN-buffer層上のALEによるa面GaNの高品質化, *第53回応用物理学会学術振興会講演予稿集,* **26,** 401, 2006年3月.
102. **石田 勝也, 榊原 友士, 三河 通男, 富永 喜久雄, 村井 啓一郎, 森賀 俊広 :** PLD法により作製したZnO-In2O3系二層膜の特性評価, *第53回応用物理学関係連合講演会,* 2006年3月.
103. **助田 祐志, 西村 勇介, 瀧田 啓介, 高田 大輔, 下村 幸司, 富永 喜久雄, 村井 啓一郎, 森賀 俊広 :** ZnO-In2O3系透明導電膜における特性のGa2O3ドーパントの添加量依存性, *第53回応用物理学関連連合講演会,* 2006年3月.
104. **松浦 一暁, 菊田 大悟, 敖 金平, 扇谷 浩通, 平本 道広, 河合 弘治, 大野 泰夫 :** SiCl4ガスを用いたICP-RIEによるAlGaN/GaN HFETのゲートリセスエッチング, *第53回応用物理学関係連合講演会,* 2006年3月.
105. **敖 金平, 長岡 史郎, 岩崎 聡一郎, 岡田 政也, 大巻 雄治, 大野 泰夫 :** EB露光CuゲートAlGaN/GaN HFETの高周波特性, *第53回応用物理学関係連合講演会,* 2006年3月.
106. **川上 烈生 :** SOLプラズマ中の炭素不純物によるタングステン材表面の損耗変化に関する研究, *平成17年度核融合科学研究所LHD数値解析システム利用共同研究報告書,* 日本, 2006年3月.